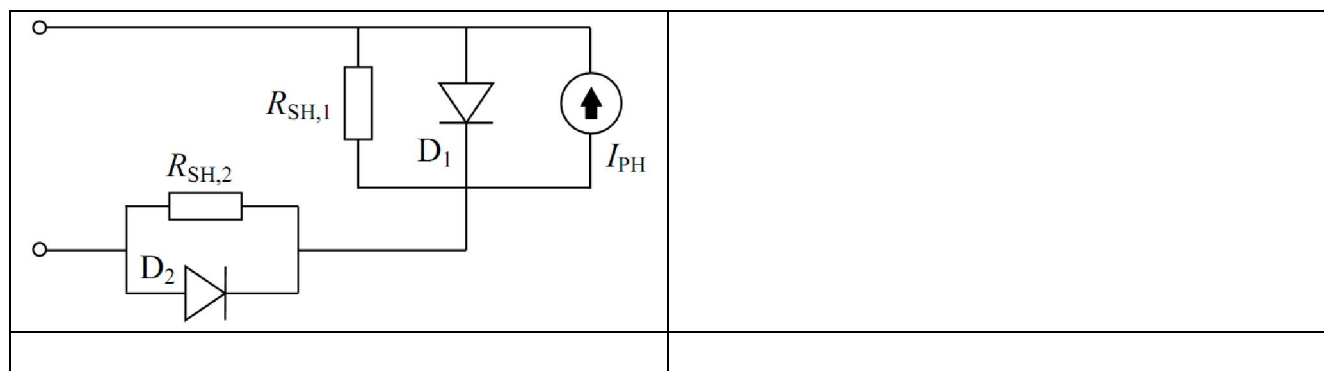


Рис.3.2 Еквівалентна схема освітленого фотоперетворювача, запропонована в [1].



3.2 Температурна залежність параметрів структури $\text{CuS}_{1.8} - \text{CdSe}$.

3.3 Фотоіндукована деградація параметрів структури $\text{CuS}_{1.8} - \text{CdSe}$.

4. Висновки

3.1. Вплив ультразвукового навантаження на напругу холостого ходу та струм короткого замикання

Одними з основних параметрів, які характеризують фотоелектричне перетворення є напруга холостого ходу та струм короткого замикання. Водночас, ці параметри відображають процеси, що відбуваються всередині